.001年 3月21日 11年時01月

NO. 0034 F. 41/33

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56127262 A

(43) Date of publication of application: 05.10.81

(51) Int. CI

G06F 13/04 G06F 3/00 G11C 9/06 G11C 29/00

(21) Application number: 55029148

(22) Date of filing: 10.03.80

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

MAEDA YUZO FUJITA HIROSHI

(54) PERIPHERAL STORAGE CONTROLLER

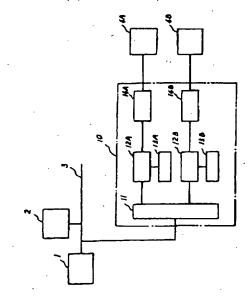
(57) Abstract:

PURPOSE: To increase extremely the reliability of write contents for the periphery devices, by storing the contents of the main storage device in each buffer memory independently and then reading these contents to write them into the duplicated peripheral devices.

CONSTITUTION: The contents of the main storage device 2 is transferred to the magnetic disk controller 10 via the common bus 3 and by an indication of CPU1. This storage information receives detection/correction and others through a parity check and the like at the interface part 11. Then the information having the same contents are stored temporarily in the buffer memories 13A and 13B independently and through the control parts 12A and 12B. After this, the parts 12A and 12B reads the contents of the corresponding memories 13A and 13B respectively and then write them into the magnetic disk devices 4A and 4B through the interface parts 14A and 14B. Accordingly the probability is small for an error of the write contents of both device 4A and 4B even if the storage information is accumulated or read out erroneously. As a result, the reliability can be

increased extremely for the write contents.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO&Japio



(9) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

6974-5B

昭56—127262

Dint. Cl.3		
GO	16 F	13/04
		3/00
G 1	1 C	9/06

29/00

職別記号 庁内整理番号 7361-5B 6711-5B 7056-5B ❸公開 昭和56年(1981)10月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

↔周辺記憶制御装置

額 昭55-29148

❷出 簡 昭55

②特

頁 昭55(1980)3月10日

砂発 明 者 前田雄三

横浜市戸塚区戸塚町216番地株 式会社日立製作所戸塚工場内

10発 明 者 藤田浩

横浜市戸塚区戸塚町216番地株 式会社日立製作所戸塚工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

切代 理 人 弁理士 福田幸作

外1名

明 組 客

発明の名称 総辺記憶副御袋置

特許請求の疑選

1 、中央処理装置の指示に従い、主記環装置の内容を共通パスを介して収込み、2 量化された間辺記憶装置のそれぞれに対応して設けられた関連部により、これを同じく各パンファメモリモれぞれに独立に一時書成した後、これらを吹出して政告周辺記憶装置に書込みうるごとく構成したことを特象とする周辺記憶制御鉄度。

発明の詳細な説明

本発明は、情報的無額選択かいて、2 食化した 周辺記憶製選に対する関辺記憶制額装蔵に関する ものである。

まず、従来技術について説明する。

据1回は、従来の周辺記憶制御鉄道の一例のプロック部であつて、磁気ディスク制御鉄道に対するものである。

ととで、中央処理設備 I の指示により、主記憶 数置 2 の所定内容を収出し、2 重化して設けられ 大磁気デイスタ領電 4 A、 4 Bに参込む場合の磁気デイスク製御装置 5 の動作を説明する。

中央処理鉄道1の指示により、主記は鉄道2の 所定記憶情報が共通パス3を介して磁気ディスク 新御鉄道5へ転送される。

この記憶情報は、インタフェース部6、制御部7を介してパッファメモリ8に一時書積される。 この際、インタフェース部6では、一般に、その記憶情報がパリティチェック等によつて割り検出、釘正が行われる。

次に、前郷部1は、パンファメモリ8の内容を 飲出し、デバイスインタフェース部9点、9日を 通し、同一内容のものを同時に、磁気デイスタ級 ほ4点、4日に参込む。

この場合、インタフェース部8で誤り改出、訂正がなされた正しい内容の当該記憶情報が、インタフェース部8を通過後、銀つてパッフアメモリ8に答込まれたとも、または正しく答込まれたものがパッフアメモリ8から銀つで就出されたと8には、2重化された磁気ディスク強度4人、4B

(1)

へ同時に観つたデータを普込んでしまりことになる。 ス

とのように、高1図の使来例は、折角、周辺記 爆撃機を2ま化しても、元分な信頼性が得られな い場合がありうるという問題を有していた。

本発明の目的は、上記した従来投資の欠点をな くし、2 重化型辺記電極電の信頼性を高めること ができる過辺記電影御袋電を提供することにある。

本税明の特徴は、2 重化された周辺配値優値の それぞれに対応して、主配便装置の内容を一時書 表するパッファメモリかよび制御部を設けること 〈構成した周辺記憶勘御袋喰にある。

以下、本発明の実施例を終2回に基づいて説明 する。

第2回は、本発明に係る尚辺配備制御装置の一 表稿例のプロック図である。

とこで、1 は、中央処域模型、2 は、主記電装置、8 は、共通パス、4 A、4 B は、周辺記憶模型に係る機気デイスク模型、1 0 は、周辺記憶制御装置に係る磁気デイスク制御装置、1 1 は、そ

(2)

ク数遣4 A、4 Bへの書込内容のいずれかは、正 しいものであり、両者ともに観る確率は傷めて小 さいものとなるので、その信頼性が書しく向上す ス

たか、上記実施例にかいて、磁気デイスタ級者 に対する場合を説明したが、本発明は、これに限 足されるものではない。すなわち、周辺記憶鉄道 として、磁気ドラム装置。磁気テーブ装置その心 のものを用いても、3 然、その実施をすることがで まることは明らかである。

以上、幹細化説明したように、本発明によれば、 電辺記憶制製袋堂の制御部。パッフアメモリ等に 若干のハードウェアの増加を必要とするが、2 重 化周辺記憶袋屋の配偶情報の信頼性を振聞的に向 上せしめることができるので、これを稀つて余り あるものであり、繊維を効果が得られる。

図面の簡単な説明

第1回は、従来の周辺紀律制御袋収の一例のアロック的、第2回は、本発明に係る周辺記律制御袋配の一実権例のアロック回である。

投票項56-127262(2)

のインタフェース部、12A.12Bは、何創知 部、13A.13Bは、何パッファメモリ、14A. 14Bは、同デバイスインタフエース部である。

中央処無終値1の指示により、主記律帳置2の 所定内容(記憶情報)が共通パス3を介して磁気 デイスク制御鉄道10へ転送される。

この記憶情報は、インタフエース部11でパリテイチェンク等による数り検出、訂正、その他必要な処理がなされた後、制御部12A、12Bを近して、それぞれ、同一内容のものがパンファメモリ13A、13Bに独立に一時書積される。

次に、制御部12A、12Bは、それぞれ、対応するパッファノモリ13A、18Bの内容を飲出し、これらをデバイスインタフェース部14A。14Bを通して磁気デイスク装置4A。4Bに登込む。

このようにするととによつて、パッファメモリ 13A,13Bのいずれかについて、万一、記憶情報が観つて一時書積され、または正しく一時書 積されたものが鋭つて説出されても、磁気デイス

(4)

1 …中央組織装置、2 …主記憶装置、3 …共通パス、4 人、4 B … 磁気デイスク装置、1 0 …磁気デイスク制御装置、1 1 …インタフエース部、1 2 人、1 2 B … 刻御部、1 3 人、1 3 B … パッフアメモリ、1 4 人、1 4 B … デパイヌインタフエース部。

代理人 弁度士 福田単作。 (ほか1名)

将附昭56-127262(3)

